砂日本国特許庁(JP)

の特許出 關公開

# ® 公開特許公報(A) 昭60-195957

@Int\_Cl\_4

識別記号 庁内整理番号

**母公開** 昭和60年(1985)10月4日

H 01 L 23/48 23/28 7357-5F 7738-5F

客査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

60発明の名称

リードフレーム

②特 頤 昭59~50939

❷出 顧昭59(1984)3月19日

砂発明 者

喬太

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

砂光 明 者 切出 顧 人

中 次 并 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

砂代 理 人 弁理士 高橋 明夫

Ш

外1名

#### 明細 11

発明の名称 リードフレーム

#### 存許請求の範囲

1. 傷面に突出部を設けて成ることを特象とする リードフレーム。

2. 前記リードフレームがプラステックモールド 用リードフレームである、特許請求の範囲第1項 記載のリードフレーム。

## 発明の詳細な説明

# 〔技術分野〕

本発明はリードフレームに関し、特に、モール ドレジンとの密着性を良くし、対止性のよい樹脂 対止型半導体装置を得ることができるリードフレ ームに関する。

## [ 背景技術]

リードフレームの構造の一例としては第1箇に 示すごときものが周知である(工業調査会刊「IC 化実装技術」 P137~P150 など)。第1週に て、1は半導体テップをマウントするタブ、2は このタブを吊っているタブ吊りリード、3は半導

THE REPORT OF THE PERSON OF TH

体チップの内部配線をコネクタワイヤにより外部 に引出するリードである。このリード側の電板及 び半導体チップ側の電極をコネクタワイヤを用い て、周知の超音波ボンディング法などによりボン ディングして電気的姿貌を行った後に、樹脂(レ ジン)を周知のトランスフェーモールド法などに より半導体チップやボンディング部上にモールド し、リード3を切断成形するなどして樹脂對止型 の半導体接受を得ることができる。

ところで、かかる樹脂對止型半導体装置にあっては、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、對止性(耐運性)を向上させ、信頼度を向上させることが必要であり、近時は半導体チェブの大形化に伴ない、對止巾が増々狭くなっており、これら事項の重要性も増大している。

従来のこのような樹脂對止型の半導体製置に使用されるリードフレームにあっては、その側面がフラットに構成されており、リードフレームとレクンとの密着性が不足し、對止性、信頼度の向上という面で問題があることがわかった。

#### (発明の目的)

本発明はリードフレームとレジンとの密着(接触)面積を増大させて、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、対止性を向上し、信頼度の高い樹脂封止型半導体装置を得ることができるリードフレームを提供することを目的としたものである。

本発明の前記ならびドモのほかの目的と新規な 特徴は、本明細書の記述および続付図面からあき らかドなるであろう。

## [ 発明の概要]

本裏において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下配のとおりである。

すなわち、本発明ではリードフレームの側面に 飲付けを行い、レジンとの接触面を増大させ、リ ードフレームとレジンとの密着性を良好にし、リ ードフレーム表面模増大によるリークパスの伸長 をはかって外部からの復気等の浸透性異物の侵入 の半導体チップへの到遠時間を長くして、剣止性 を内上させ、製品券命を延命し、信頼性を向上させることに成功した。

## 〔與始例〕

次に、本発明を実施例に基づき説明する。 第2回は本発明リードフレームの要部針視回、 第3回は第2回I-I設断面回を示す。

これら図において、4 は半導体チェブを搭載するためのタグではタブ吊りリード、6 はリード、7 は歯の人でのからなどに必要な樹脂穴である。本発明りように、タブルトにあっては、パードングのでは、これら図に例示するように、タブルトングのでは、これら図に例示するように、タブルトングのでは、通常の方法により側面がファートの関端を上下から変出するように形成してもよいもののでは、アンスの関端を上下から変出するように形成してもよいから変なが採用できる。これでは、その他選集から流流により形成してもよく、その他選集の方法が採用できる。

第4回は本発明リードフレームを使用して成る

樹脂對止型半導体接置の断面図を示し、第4図にて、9は半導体チェブ、10はコネクタワイヤ、11は樹脂對止体、12はリードフレームで半導体チェブ9を搭載しているタブ13、及び半導体チェブ9の内部配擬をコネクタワイヤ10を用いて外部に引出するリード14にはそれぞれ突出部15が設けられている。

本発明リードフレームは、例えば42アロイ合金により構成される。半導体チップ9は、例えば シリコン単結晶基板より成り、周知の技術によっ て、このチップ内には多数の国路果子が形成され、 1つの回路機能を与えている。回路果子は例えば 絶縁ゲート型電界効果トランジスタ(MOSトラ ンジスタ)から成り、これらの国路果子によって、 例えば論理回路およびメモリの国路保能が形成されている。コネクタワイヤ10は、例えばアルミ ニウム(A8)細線により構成される。

樹脂封止体11は、例えばエポキン樹脂により 構成され、周知のトランスファーモールド法など により形成される。次に、第5回は本発明の他の 実施例を示し、第2 図に示すリードフレームのリード6の上面に、さらに、適宜の関隔で横方向に 複数の線条の課部16を設けて成る実施例を示す。 近時、第4 図に示すような側距封止型半導体装置 において、半導体チップ9が大形化し、リード14 の側距射止体11に担込まれる長さが次算に短く なってきている。そうすると、リード14を折曲 げて第4 図に示すような折曲げリードとする場合、 折曲げ時にリードがゆるみ、リードがレジンから スリップし、リードが関節対止体外部によけいに 引っぱり出されることになる。かかる課部16を 設けることにより、より一層、リードフレームと レジンとの密着性を向上し得る。

### 〔劝 录〕

- (1) リードフレームの切断面に設付けを行ない、 側面に突出部を形成するようにしたので、その分 リードフレームとレジンとの密着面積が増大し、 リードフレームとレジンの密着性の向上が図られ
- (2) 密着面積の増大により、レジン量が増大し、

# 特用昭60-195957(3)

かつ、側面がフラットである場合に比較して、飲か形成されているのでリータペスが長くなり、その結果外部からの半導体製量内部への長遠性異常の侵入が遅くなり対止性(耐湿性)が向上する。(3) リードフレームとレジンとの密着性、対止性等の向上により製品寿命を延命し、機能対止型半導体製造の信頼性を著しく向上することができる。(4) 半導体チップが大型化し、リードのモールドレジン中へ組め込まれている部分が増々短くい、リードフレームとレジンとの密着性の向上の関・・対した、半導体装置の信頼性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、

(5) リードフレームの何節に突出部を設けること に加えて、第5回に示すように、リードの上面に 講部を形成することにより、より一層リードフレ ームとレジンとの告着性が向上させることができ、 さらにリード折曲げ成形に築し、リードがゆるん だり、樹脂刺止体の外部に突出したりすることを 防止できる。 以上本発明者によってなされた発明を実施例にもとづき具体的に説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、その要旨は逸脱しない範囲で確々変更可能であることはいうまでもない。

例えば、前配実施例では、リードフレー 4 質面 全体に突出部を設けた例を示したが、一部に突出 部を設けても差支えない。又前配実施例では評部 をリード上面のみに設けた例を示したが、リード の上下面あるいは下面のみに設けてもよい。

[利用分野]

本発明はデュアルインライン(DIL)タイプのパッケージの体、フラットパッタタイプのパッケージなど他の複数対止選半導体装置にも適用することができ、複数対止選半導体装置会紋に適用できる。 又電子部品のパッケージ技術にも適用できる。 図面の簡単な説明

第1回はリードフレームの従来例を示す平面図、 第2回は本発明リードフレームの要部所視図、 第3回は第2回IーI継所図図、

第4回は本発明リードフレームを使用して成る 樹脂對止型半導体装置の断面面、

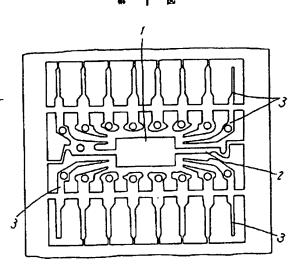
第5回は本発明の他の実施例を示すリードフレ

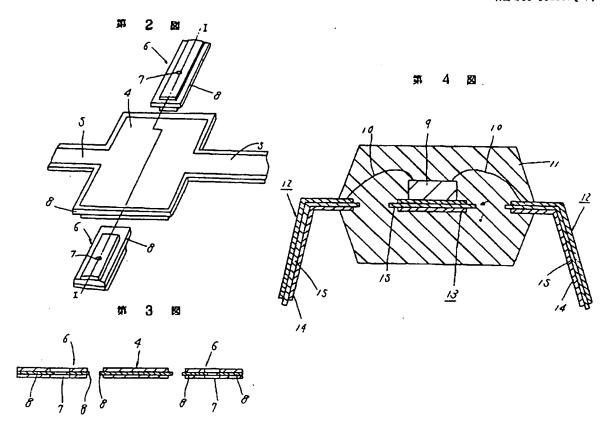
ームの平面図である。

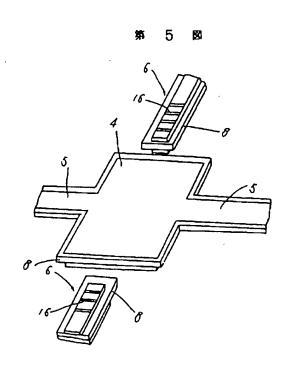
1…タブ、2…タブ吊りリード、3…リード、

- 4…タブ、5…タブ南ザリード、6…リード、7
- …樹脂穴、8 …突出部、9 …半導体デッグ、10 noverior will noverior will noverior will noverior will 11 …樹脂對止体、12 … yeadframe
- F7 V-A, 13 F7, 14 9 F, 15

代理人 弁理士 高 曇 明 夫







# Abstract of Japanese Patent Office Gazette

No. H6-140563

# SEMICONDUCTOR DEVICE

Inventor:

Tsuji Masahiro

Applicant:

Rohm Co., Ltd.

Filed:

Oct. 23, 1992

Disclosed:

May 20, 1994

PURPOSE: To provide a semiconductor device prevented from generating the exfoliations of a resin from a die pad in a chain-reacting way and from generating the cracks of the resin, by improving the adhesiveness of the resin to the die pad in the corner of the die pad wherein the exfoliations are especially apt to occur, in the resin-sealed semiconductor device including a semiconductor chip die-bonded to the die pad.

CONSTITUTION: On each sidewall of a die pad 1, a recessed part 11 or a protruding part or the combination thereof is formed. Then, a resin 6 is made to eat into the recessed part 11 or to cover completely the protruding part, and concurrently, the effect of the difference between the thermal expansion coefficients of the resin 6 and the die pad 1 is made small by covering thin protruding parts 12 of the die pad 1 with the resin 6. Thereby, the adhesiveness of the resin 6 to the die pad 1 is improved.